

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【公表番号】特表2009-530828(P2009-530828A)

【公表日】平成21年8月27日(2009.8.27)

【年通号数】公開・登録公報2009-034

【出願番号】特願2009-500541(P2009-500541)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/762 (2006.01)

H 0 1 L 21/76 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/76 D

H 0 1 L 21/76 L

H 0 1 L 27/12 F

H 0 1 L 27/12 L

H 0 1 L 29/78 6 1 8 D

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 1

H 0 1 L 27/08 1 0 2 A

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月20日(2010.1.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子デバイスの形成方法であって、

基板の上に位置する半導体層の上にパターン形成された耐酸化層を形成することと、

半導体層をパターン形成して第 1 の半導体島を形成することと、第 1 の半導体島は第 1 の表面と、第 1 の表面に対向する第 2 の表面とを含むことと、第 1 の表面は第 2 の表面と比較して基板のより近くに位置していることと、

第 1 の半導体島の側面に沿って耐酸化材料を形成することと、

パターン形成された耐酸化層、第 1 の半導体島および耐酸化材料を酸素含有雰囲気に出露することと、パターン形成された耐酸化層、第 1 の半導体島および耐酸化材料を酸素含有雰囲気に露出している間に、第 1 の表面に沿った第 1 の半導体島の第 1 の部分は酸化されることと、からなる方法。

【請求項 2】

パターン形成された耐酸化層、第 1 の半導体島および耐酸化材料を酸素含有雰囲気に出出した後で、パターン形成された耐酸化層を除去することを含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

パターン形成された耐酸化層、第 1 の半導体島および耐酸化材料を酸素含有雰囲気に出した後で、耐酸化材料を除去することを含む請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

パターン形成された耐酸化層および耐酸化材料は窒化物を含む請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

パターン形成された耐酸化層、第 1 の半導体島および耐酸化材料を酸素含有雰囲気に出することは、約 800℃以上の温度で実行される請求項 4 に記載の方法。